

REC'D 25 OCT 2004

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ufficio G2

Per:

Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per: INVENZIONE INDUSTRIALE N. TO 2003 A 000774 depositata il 03.10.2003.

Si dichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali depositati con la domanda di brevetto sopra specificata, i cui dati risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

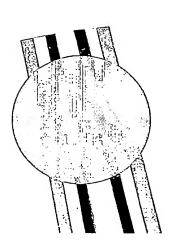
ROMA II..... 2.8. SET. 2004

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

IL FUNZIONARIO

Giampietro Carlotto C



1VIUDULU A (1/2)

· AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (U.I.B.M.)

DOMANDA	DI BREVETTO	PER INVENZION	JE INDLISTR	TATENIO

	:	10	
(Parties)	1	A CONTRACTOR	
	CAMERA DI COMA	人员过行	
U 750	INDUSTRIA ARTIGO	WO LAG	
(iii	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,33-]	uro

A. RICHIEDENTE/I						44	0000		~	for me ex ning . bearing
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1	C.R.I	F. SOCI	ETÀ C	CONSO	RTILE PI	2003A	0007	7	8
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2	PG	COD. I	FISCALI FA IVA	E A3	07084	560015			
INDIRIZZO COMPLETO	A4	STRA				43 ORE	BASSANO TO	IMAR	A GLR(O)	
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1							j		TARA
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2			FISCALI FA IVA		Ī		15		10,33 Euro
INDIRIZZO COMPLETO	A4		1					· ·	11 ±	-
A. RECAPITO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI MANDATARIO	во		(D = E	ООМІСІ	LIO ELBI	TIVO, R =	RAPPRESENTANTE)		A CO	
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	B1							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		52 Euro cent
INDIRIZZO	B2			-						
CAP/LOCALITÀ/PROVINCIA	В3									
C. TITOLO	C1	"DISI	POSITIV	OSEN	ISORE I	OI PRESS	IONE, RELATIVO	PROCEDIMENTO D	I FAB	BRICAZIONE E
		PROC	EDIMEI	NTO D	I RILEV	AZION.	E DI PRESSIONE"			
D. INVENTORE/I DESIGNAT	LO\I	(DA IN	DICAR	E ANC	HE SE	L'INVE	TORE COINCIDE	CON IL RICHIED	ENTE)	
COGNOME E NOME	D1	PULL	INI DA	NIE <u>LE</u>	!					
NAZIONALITÀ	D2	ITAL	IANA			···.		•		
COGNOME E NOME	D1	PERL	O PIERO)						
NAZIONALITÀ	D2	ITAL	IANA							
COGNOME E NOME	D1									
NAZIONALITÀ	D2		-	-						
COGNOME E NOME	D1				-					
NAZIONALITÀ	D2						•			
	SEZ	ZIONE		Cı	LASSE		SOTTOCLASSE	GRUPPO		SOTTOGRUPPO
E. CLASSE PROPOSTA	E1			E2		7	E3	E4	7	E5
F. PRIORITA'		DERIVA	NTE DA PR	ECEDEN	TE DEPOS	ITO ESEGU	TTO ALL'ESTERO			
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		·-·					Tipo	F2	
NUMERO DI DOMANDA	F3			_				DATA DEPOSITO	F4	
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1							TIPO	F2	
NUMERO DI DOMANDA	F3							DATA DEPOSITO	F4	
G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICROORGANISMI	G1		•							
FIRMA DEL/DEI			uro MA		ELL	>		-		
RICHIEDENTE/I			rio e pe		altri)					ĺ

[. MANDATARIO DEL RICHI LA/E SOTTOINDICATA/E PERSONA/E HA/ TALIANO BREVETTI E MARCHI CON L'INC.	/HANN	ASSUNTO IL MANDATO A	RAPPRESENTARE IL TITOLAR	re della presente domanda innan 20.10.1998 N. 403).	IZI ALL'UFF	icio
Numero Iscrizione Albo	I1	N. ISCR. ALBO 259 I	BUZZI FRANCO; N. IS	CR. ALBO 258 NOTARO GIA	NCARLO	 -
COGNOME E NOME;			•	J. ISCR. ALBO 507 MARCHIT		
		N. ISCR. ALBO 335 S				,
3	TO			D.Y.		
DENOMINAZIONE STUDIO	I2		NTONIELLI D'OULX S.I	K.L.		
Indirizzo	13	VIA MARIA VITTORIA	4, 18			
CAP/Località/Provincia	I4	10123 TORINO - TO				
L. ANNOTAZIONI SPECIALI	L1		·			
M. DOCUMENTAZIONE AL	LEG	TA O CON RISER	VA DI PRESENTAZI	IONE		
TIPO DOCUMENTO		N. Es. Ris.	N. PAG. PER ESEMPLAI	RE .		
PROSPETTO A, DESCRIZ., RIVENDICAZ. (OBBLIGATORI 2 ESEMPLARI)		2	21			
DISEGNI (OBBLIGATORI SE CITATI IN DESCRIZIONE, 2 ESEMPLARI)		2	5			
ESIGNAZIONE D'INVENTORE						
DOCUMENTI DI PRIORITÀ CON TRADUZIONE IN ITALIANO						
AUTORIZZAZIONE O ATTO DI CESSIONE	1	SI/NO)]			
Lettera d'Incarico		Sì				
PROCURA GENERALE		NO				
RIFERIMENTO A PROCURA GENERALE		NO				
		me/Euro)	Importo V	Versato Espresso in Lettere		
ATTESTATI DI VERSAMENTO		€ DUECENTO	NOVANTUNO/80 (€ 29	9 1,80)	,^	
FOGLIO AGGIUNTIVO PER I SEGUENTI PARAGRAFI (BARRARAE I PRESCELTI) DEL PRESENTE ATTO SI CHIEDE COPIA AUTENTICA? (SI/NO) SI CONCEDE ANTICIPATA ACCESSIBILITA AL PUBBLICO? (SI/NO) ATA DI COMPILAZIONE	L	Sì NO 2 OTTOBRE 2003	F			
		auro MARCHITTHA	7			
RICHIEDENTE/I	(In p	oprio e per gli altri)				
			E DI DEPOSITO)		
NUMERO DI DOMANDA	A	102003	3A0007	Value 1		
C.C.I.A.A. D	ı TC	RINO			COD.	01
IN DATA	A 3 C	TTOBRE 2003 , IL/I	RICHIEDENTE/I SOPRAIN	NDICATO/I HA/HANNO PRESENTA	TO A ME	
LA PRESENTE DOMANDA O	ORREC	ATA DI N. FOGL	I AGGIUNTIVI PER LA CONC	CESSIONE DEL BREVETTO SOPRARIPO	ORTATO.	
N. Annotazioni Varie Dell'Ufficiale Rogante						
IL DEPOSITANTE	3		DI GOMBERGIO A ARTIGIANATO E AGRICOITUS DELL'UFFICIO	L'Ufficiale Rog Ord Mirella CAVA CATEGORI	從 LLARI	
1'				1	7.0	

PROSPETTO MODULO A DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

A. RICHIEDENTE/I COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE, RESIDENZA O STATO C.R.F. SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI STRADA TORINO 50, 10043 ORBASSANO TO C. TITOLO "DISPOSITIVO SENSORE DI PRESSIONE, RELATIVO PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE E PROCEDIMENTO DI RILEVAZIONE DI PRESSIONE" PRODU RESIDENZA O STATO C. TITOLO "DISPOSITIVO SENSORE DI PRESSIONE, RELATIVO PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE E PROCEDIMENTO DI RILEVAZIONE DI PRESSIONE" STATICALIONI PRODU RESIDENZA O STATO C. TITOLO "DISPOSITIVO SENSORE DI PRESSIONE, RELATIVO PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE E PROCEDIMENTO DI RILEVAZIONE DI PRESSIONE"
STRADA TORINO 50, 10043 ORBASSANO TO C. TITOLO "DISPOSITIVO SENSORE DI PRESSIONE, RELATIVO PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE E PROCEDIMENTO DI RILEVAZIONE DI PRESSIONE"
"DISPOSITIVO SENSORE DI PRESSIONE, RELATIVO PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE E PROCEDIMENTO DI RILEVAZIONE DI PRESSIONE"
Samogen C Is purvent 10,33
SEZIONE CLASSE SOTTOCLASSE GRUPPO SOTTOGRUI

E. CLASSE PROPOSTA

P. RIASSUNTO

DISPOSITIVO SENSORE DI PRESSIONE MAGNETICO DEL TIPO CHE COMPRENDE ALMENO UNO STRATO MAGNETICO (11) ATTO A VARIARE UNA MAGNETIZZAZIONE AD ESSO ASSOCIATA IN RISPOSTA A UNA PRESSIONE (P) SU DI ESSO ESERCITATA. DETTO DISPOSITIVO (20; 30; 40; 50) COMPRENDE UNA PLURALITÀ DI STRATI (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) DISPOSTI IN PILA, DETTO STRATO MAGNETICO (11) ATTO A VARIARE UNA MAGNETIZZAZIONE AD ESSO ASSOCIATA IN RISPOSTA A UNA PRESSIONE (P) COMPRENDENDO UNO STRATO MAGNETICO LIBERO (11), ASSOCIABILE A UNA MAGNETIZZAZIONE TEMPORANEA (MT), DETTO STRATO MAGNETICO LIBERO (11) APPARTENENDO A DETTA PLURALITÀ DI STRATI (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), LA QUALE COMPRENDE INOLTRE ALMENO UNO STRATO SPAZIATORE (13; 23; 33) E UNO STRATO MAGNETICO PERMANENTE (12) ASSOCIATO A UNA MAGNETIZZAZIONE PERMANENTE (MP), DETTO DISPOSITIVO SENSORE (20; 30; 40; 50) COMPRENDE INOLTRE UNO STRATO COMPRIMIBILE (21; 31; 42) E UNO STRATO AD ALTA COERCITIVITÀ MAGNETICA (22; 32; 42) ASSOCIATI A DETTA PLURALITÀ DI STRATI (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). (FIGURA 2A)

P. DISEGNO PRINCIPALE

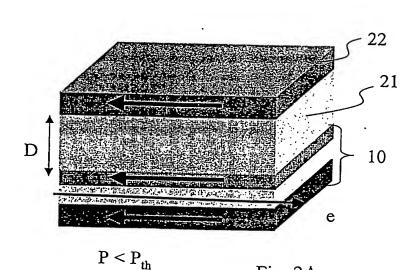


Fig. 2A

FIRMA DEL/DEI

RICHIEDENTE/I

Ing. Mauro MARCHITELLI
N. Techt. At Bo Ger
(In proprio e per gli altri)



DESCRIZIONE dell'invenzione industriale dal titolo:
"DISPOSITIVO SENSORE DI PRESSIONE, RELATIVO
PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE E PROCEDIMENTO DI
RILEVAZIONE DI PRESSIONE"

di: C.R.F. Società Consortile per Azioni, nazionalità italiana, Strada Torino 50, 10043
Orbassano TO

Inventori designati: PULLINI Daniele; PERLO Piero
Depositata il: 3 ottobre 2003 702003 A000774

TESTO DELLA DESCRIZIONE

La presente invenzione riguarda un dispositivo sensore di pressione magnetico, del tipo che comprende almeno uno strato magnetico atto a variare una magnetizzazione ad esso associata in risposta a una pressione esercitata su detto stesso strato magnetico.

Nel campo dei sensori di pressione i dispositivi più impiegati per applicazioni che richiedano rilevazioni in situ tramite sensori realizzati in tecnologia a film sottile, sono i dispositivi cosiddetti 'strain gauge', che utilizzano sostanzialmente piastrine sulle quali depositati dei ponti formati da strati da materiale piezoelettrico. Tali sensori sono di tipo analogico possono talvolta non essere adatti alla

rilevazione di soglie di pressione con sufficiente sensibilità e rapidità di commutazione.

Sono anche noti sensori magnetici a film sottile sfruttano che le proprietà magnetostrittive strati magnetici. Tuttavia tali strati sono di difficile costruzione, fragili hanno una sensibilità limitata.

La presente invenzione si prefigge lo scopo di realizzare una soluzione in grado di fabbricare un dispositivo sensore di pressione magnetico in tecnologia a film sottile di facile realizzazione e dotato di elevata robustezza e sensibilità.

Secondo la presente invenzione, tale scopo viene raggiunto grazie ad un dispositivo sensore di pressione e a un corrispondente procedimento fabbricazione, nonché un corrispondente procedimento di rilevazione di pressione aventi le caratteristiche richiamate in modo specifico nelle rivendicazioni che seguono.

L'invenzione verrà descritta con riferimento ai disegni annessi, forniti a puro titolo di esempio non limitativo, in cui:

- la figura 1 rappresenta uno schema di principio di un dispositivo magnetico di tipo spin valve;
 - le figure 2A e 2B rappresentano schemi di

principio in due diversi stati di funzionamento di un dispositivo sensore di pressione secondo l'invenzione;

- la figura 3 rappresenta uno schema di principio di una prima variante al dispositivo sensore di pressione secondo l'invenzione;
- la figura 4 rappresenta uno schema di principio di una seconda variante al dispositivo sensore di pressione secondo l'invenzione;
- la figura 5 rappresenta uno schema di principio di una terza variante al dispositivo sensore di pressione secondo l'invenzione;
- la figura 6 rappresenta un esempio applicativo del dispositivo sensore di pressione secondo l'invenzione.

Il dispositivo sensore di pressione proposto prevede di sfruttare per la rilevazione dispositivi magnetici cosiddetti 'spin valve' o valvole di spin. Una spin valve è un dispositivo costituito in generale da una successione di strati di materiali differenti.

La struttura di un dispositivo magnetico di tipo spin valve 10 é rappresentata in maniera schematica in figura 1. Tale spin valve 10 comprende una pluralità di strati di differenti materiali impilati. Tale pluralità di strati comprende, in

particolare, un sottostrato 14, ad esempio sottostrato di vetro, sul quale è depositato uno crescita 15, detto anche seed layer, strato di realizzato ad esempio tramite uno strato di tantalio, che serve da seme per la crescita di uno strato magnetico permanente 12.

In figura 1 detto strato magnetico permanente 12 mostrato composto da due strati, uno magnetico vincolato 12A, detto anche 'pinned layer', e uno strato antiferromagnetico vincolante 16, detto anche 'pinning layer'. Lo strato antiferromagnetico 16 produce un campo magnetico a corto raggio che influenza e vincola una magnetizzazione permanente MP dello strato vincolato 12A, che non può più eventuale campo sequire un magnetico esterno. L'insieme degli strati 12A e 16 si comporta di fatto come un magnete permanente ad alta coercitività magnetica e fornisce un campo di riferimento alla spin valve 10.

Lo strato magnetico permanente 12 può alternativamente essere realizzato tramite la semplice deposizione di un solo strato magnetico duro, ad esempio uno strato di cobalto.

Lo strato antiferromagnetico 16 della spin valve 10 è realizzato, ad esempio, per mezzo di una lega NiMn. Tale strato antiferromagnetico 16 è poi

ricoperto da uno strato di passivazione 17, anch'esso realizzato in tantalio.

Superiormente allo strato magnetico permanente 12 è posto uno strato spaziatore non ferromagnetico 13.

E' noto impiegare uno strato sottile di rame per realizzare tale strato spaziatore 13 nel caso la spin valve 10 sia del tipo GMR (Giant Magneto Resistance) spin valve, oppure uno strato di dielettrico, ad esempio un ossido quale Al₂O₃ oppure SiO_x, nel caso la spin valve 10 sia del tipo TMR (Tunnel junction Magneto Resistance) spin valve. Sullo strato spaziatore 13 viene depositato uno strato magnetico libero 11.

Lo strato magnetico libero 11 è costituito da un materiale magnetico dolce come, ad esempio, una lega ferro-nichel come il permalloy, dotato di una magnetizzazione temporanea MT, cioè non permanente. Tale strato magnetico libero 11 ha la funzione di orientare la sua magnetizzazione temporanea MT seguendo il campo magnetico esterno che si vuole rivelare.

La spin valve 10 illustrata in figura 1 è di tipo CIP (current in plane), cioè ad essa, tramite un generatore 19, è applicata una corrente I che scorre planarmente nello strato spaziatore 13 e negli altri strati della spin valve 10. Lo strato spaziatore 13 quindi è lo strato che concorre maggiormente a determinare la resistenza elettrica in assenza di campo magnetico della spin valve 10. Sono anche possibili configurazione CPP (Current Perpendicular to Plane) nelle quali la corrente I viene forzata ad attraversare verticalmente la pila degli strati della spin valve.

In assenza di un campo magnetico esterno, spin valve mostrata in figura 1 è in configurazione ferromagnetica, cioè lo strato magnetico libero 11 e lo strato magnetico permanente 12 hanno la stessa direzione di magnetizzazione. Dunque la spin valve in questo caso presenta alta conducibilità elettrica, in quanto il percorso degli elettroni all'interno del dispositivo non subisce sostanzialmente scattering.

În presenza di un campo magnetico esterno direzione opposta al campo magnetico di riferimento, dovuto allo strato magnetico permanente, della spin valve, la spin valve è in configurazione antiferromagnetica è presenta una bassa conducibilità elettrica. Infatti, il percorso degli elettroni nello strato spaziatore e nell'intera spin valve deve sottostare a un consistente fenomeno di scattering.

figura 2A è rappresentato un sensore di pressione 20 secondo l'invenzione, il quale è basato sostanzialmente, come qià accennato, funzionamento di una spin valve, TMR (Tunnel junction Magneto Resistance) oppure **GMR** (Giant Magneto Resistance),

Più specificamente, tale sensore di pressione 20 prevede di depositare, su un dispositivo spin valve 10 analogo a quello mostrato in figura 1, uno strato comprimibile 21, realizzato attraverso un polimero, elastomero o gel, che sia comprimibile attraverso l'applicazione di una pressione e si comporti in maniera resiliente. Tale strato comprimibile 21 viene depositato al di sopra dello strato magnetico libero 11.

Sullo strato comprimibile 21 è depositato quindi uno strato magnetico ad alta coercitività 22, che si comporta come un magnete permanente e al quale è associata una magnetizzazione di saturazione tale da essere in grado di indurre una commutazione della magnetizzazione di detto strato magnetico libero 11.

Per un valore della pressione P esercitata perpendicolarmente sullo strato comprimibile 21 minore di una pressione di soglia $P_{\rm th}$, uno spessore D dello strato comprimibile 21 risulta maggiore di uno spessore di soglia $P_{\rm th}$, tale che lo strato magnetico

ad alta coercitività 22 è ad una distanza tale dallo magnetico strato libero 11, che tale strato magnetico libero 11 può orientarsi lungo direzione predefinita e preferenziale, il cosiddetto asse di facile magnetizzazione, o 'easy axis', che può essere parallelo, come mostrato in figura 2A, o anti-parallelo rispetto alla magnetizzazione dello strato magnetico permanente 12.

Nel sensore 20 è forzata, come già nel caso illustrato in figura 1, una corrente elettrica I lungo una direzione orizzontale, lungo i piani definiti dagli strati del sensore 20.

Nella figura 2A la spin valve 10 è mostrata in "configurazione parallela". Ciò significa che lo strato magnetico libero 11 e lo strato magnetico permanente 12 sono magnetizzati in assenza di campo magnetico esterno nella medesima direzione e verso. In tale configurazione il sensore 20 presenta alla corrente I un valore di resistenza elettrica basso.

Quando la pressione P è maggiore della pressione di soglia P_{th} , lo strato magnetico ad alta coercitività 22 si trova a una distanza inferiore alla distanza di soglia D_{th} dallo strato magnetico libero 11 e ne forza perciò la commutazione della direzione di magnetizzazione. In altre parole, lo strato magnetico libero 11 si orienta seconda le

linee del campo prodotto dallo strato magnetico ad alta coercitività 22; quindi, in virtù dell'incremento della pressione P, la spin valve 10 commuta in configurazione anti-parallela, induce uno scattering nel percorso degli elettroni, indicato con il riferimento 'e' in figura 2A e 2B, e assume consequentemente una alta resistenza elettrica rispetto alla corrente Ι che viene forzata orizzontalmente nel sensore 20.

Dunque un sensore di pressione quale quello proposto è in grado di segnalare le transizioni di pressione attraverso una pressione di soglia $P_{\rm th}$.

La pressione \mathtt{di} soglia P_{th} dipende dalle dimensioni fisiche dello strato elastico, in particolare dallo spessore D, dal valore di magnetizzazione di saturazione dello strato magnetico ad alta coercitività 22 e dalle caratteristiche intrinseche della spin valve 10.

Lo strato comprimibile 21 può essere realizzato per mezzo di un materiale composito poroso.

Lo strato comprimibile 21 in elastomero può essere depositato tramite un processo di spinning, diluendo opportunamente l'elastomero in maniera analoga a come viene diluito un resist da un solvente che evapora durante la deposizione, tramite un processo di casting, cioè colandolo sopra la spin

valve come un silicone, per evaporazione (termica, electron beam, sputtering, CVD.

Lo strato magnetico ad alta coercitività 22 può essere depositato per evaporazione di tipo termica, electron beam, sputtering o CVD, oppure elettrodepositato mediante cella elettrochimica.

In figura 3 è descritta una differente forma di attuazione nella quale un sensore di pressione 30 prevede uno strato comprimibile 31 comprende elastomero in forma di gel, schiuma o un liquido comprimibile. Lo strato comprimibile 31 è contenuto di all'interno uno strato magnetico ad alta coercitività 32 realizzato in materiale composito 34, in particolare una matrice elastica 35, che può essere un polimero o una resina elastica, nella quale sono incorporate particelle magnetiche 33, di cioè particelle in grado avere una magnetizzazione residua, di dimensione variabile fra il millimetro e il nanometro, orientate mediante un magnetico durante la fase esterno deposizione, esempio un processo di casting in campo magnetico.

La magnetizzazione di saturazione delle singole particelle 33, la loro densità e dimensioni determinano la magnetizzazione di saturazione finale del magnete permanente.

Le particelle magnetiche 33 possono essere realizzate separatamente o in situ dentro il polimero che costituisce la matrice elastica 35 del materiale composito 34.

In figura 4 è mostrato un dispositivo sensore di pressione 40, variante alla forma realizzativa di figura 3, dove il substrato 14 è essere scavato per etching e la spin valve 10 depositata sul fondo di una buca 36 così ottenuta.

Analogamente alla realizzazione di figura 3A, lo strato compressibile 31, successivamente depositato, ingloba la spin valve 10 e uno strato ad alta coercitività magnetica 42 è depositato al di sopra fino all'altezza della superficie del substrato 14.

è mostrata un'ulteriore realizzativa 50 del dispositivo sensore di pressione proposto, che corrisponde sostanzialmente a quella illustrata con riferimento a figura 4, eccezione fatta per l'eliminazione dello strato comprimibile 31. spin valve 10 è infatti depositato direttamente lo strato ad alta coercitività 32, comprendente particelle magnetiche 33 in una matrice elastica 35, come nel caso mostrato in figura 3. In altre parole lo strato ad alta coercitività assolve allo stesso tempo anche alla funzione di

P. La densità delle particelle 33 nella matrice elastica 35 cambia con la pressione P esterna e di conseguenza varia l'intensità del campo magnetico generato. Inoltre, quando lo strato ad alta coercitività 32 è compresso verso il basso, le linee di forza generate dalle particelle magnetiche 33 si abbassano anch'esse e sono in grado di far commutare lo strato magnetico libero 11.

sensore di pressione proposto può essere in associazione a un sistema monitoraggio e il ripristino della pressione di uno pneumatico. che prevede sostanzialmente di posizionare uno o più sensori sulla superficie interna dello pneumatico, oppure sulla superficie del cerchione della ruota che si affaccia tale pneumatico, in particolare all'interno della camera d'aria e operare il ripristino della pressione tramite una micropompa magnetica che preleva aria dall'esterno e la insuffla nella camera d'aria.

In figura 6 è mostrata perciò una ruota indicata complessivamente con il riferimento 50, che comprende un cerchione 51 e uno pneumatico 52 provvisto di un battistrada 53 e una camera d'aria 54.

Un sensore magnetico di pressione 20 è disposto

superficie interna dello pneumatico sulla 52 rileva la pressione P all'interno della camera d'aria 54, fornendo un segnale elettrico a centralina 56 disposta nello pneumatico 52 medesimo. Tale centralina 56 è preferibilmente configurata per autoalimentarsi convertendo l'energia vibrazionale al movimento della ruota 52 in energia elettrica. Tale centralina 56 è inoltre connessa a una micropompa magnetica 57, disposta passante a tenuta fra la camera d'aria 54, lo pneumatico 52, il cerchione 51 e l'ambiente esterno.

Il funzionamento del sistema proposto è il seguente: quando il sensore magnetico di pressione 20 rileva un valore di pressione P all'interno dello pneumatico 52, inferiore a un valore di soglia P_{th} , la centralina 56 comanda l'azionamento della micropompa magnetica 57, che preleva aria dall'esterno e la insuffla nella camera d'aria 54.

La soluzione appena descritta consente di conseguire notevoli vantaggi rispetto alle soluzioni note.

Il dispositivo sensore secondo l'invenzione vantaggiosamente può essere realizzato tramite tecnologie a film sottile consolidate per produzione di dispostivi spin valve, che consentono di realizzare dispositivi affidabili e di elevata

sensibilità.

In particolare, vantaggiosamente, il dispositivo sensore di pressione magnetico proposto è particolarmente adatto a realizzare 'switch' di pressione dotati di elevata sensibilità e rapidità di commutazione.

Naturalmente, fermo restando il principio del trovato, i particolari di costruzione e le forme di attuazione potranno ampiamente variare rispetto a quanto descritto ed illustrato a puro titolo di esempio, senza per questo uscire dall'ambito della presente invenzione.

Un dispositivo sensore di pressione del tipo descritto può essere impiegato in una varietà di applicazioni che prevedano la rilevazione di una pressione.

Il sistema di monitoraggio e ripristino della pressione che impiega il dispositivo proposto, può comprendere anche sensori di consumo del pneumatico temperatura o di е 0 valvole. L'autoalimentazione centralina e del sensore tramite il movimento della ruota può anche essere ottenuta tramite generazione di corrente elettrica indotta in maniera induttiva in avvolgimenti di materiale conduttore inseriti nello pneumatico accoppiati a magneti fissati sulla

scocca dell'autoveicolo o viceversa.

E' chiaro tuttavia che il dispositivo proposto può essere applicato in tutte le misure di pressione con le quali sia compatibile un dispositivo sensore di pressione magnetico del tipo che comprende almeno uno strato magnetico atto a variare una magnetizzazione ad esso associata in risposta a una pressione su di esso esercitata, e comprende inoltre una pluralità di strati disposti in pila, strato magnetico atto a variare una magnetizzazione associata in risposta a una pressione comprendendo uno strato magnetico libero associabile a una magnetizzazione temporanea, appartenente a detta pluralità di strati, tale pila comprendendo inoltre almeno uno strato spaziatore e uno strato magnetico permanente associato a una magnetizzazione permanente, detto dispositivo sensore comprendendo inoltre uno strato comprimibile e uno strato ad alta coercitività magnetica associati a detta pluralità di strati.

* * * * * * * *

RIVENDICAZIONI

- 1. Dispositivo sensore di pressione magnetico del tipo che comprende almeno uno strato magnetico (11) atto a variare una magnetizzazione ad esso associata in risposta a una pressione (P) esercitata su detto strato magnetico (11), caratterizzato dal detto dispositivo (20; 30; 40; fatto che comprende una pluralità di strati (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) disposti in pila, detto strato magnetico (11) atto a variare una magnetizzazione ad esso associata in risposta a pressione una (P) comprendendo uno strato magnetico libero (11).associabile a una magnetizzazione temporanea (MT), detto strato magnetico libero (11) appartenendo a detta pluralità di strati (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), la quale comprende inoltre almeno uno strato spaziatore (13; 23; 33) e uno strato magnetico permanente (12) associato a una magnetizzazione permanente (MP), e dal fatto che detto dispositivo sensore (20)comprende inoltre uno strato comprimibile (21; 31; 42) e uno strato ad alta coercitività magnetica (22; 32; 42) associati a detta pluralità di strati (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).
- 2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto strato

comprimibile (21; 31; 42) è depositato sullo strato magnetico libero (11) e detto strato ad alta coercitività magnetica (22; 32; 42) è depositato su detto strato comprimibile (21).

- Dispositivo secondo la rivendicazione caratterizzato dal fatto che detto comprimibile (21; 31; 42) ha uno spessore non compresso (D) tale da impedire allo strato ad alta coercitività magnetica (22) di commutare la magnetizzazione temporanea (MT) associata a detto strato magnetico libero (11).
- 4. Dispositivo secondo la rivendicazione 3 caratterizzato dal fatto che detto strato ad alta coercitività magnetica (32; 42) è realizzato tramite una struttura composita (34) comprendente particelle magnetiche (33) contenute in una matrice resiliente (35).
- 5. Dispositivo secondo la rivendicazione 4 caratterizzato dal fatto che detta pluralità di strati (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) comprende un sottostrato (14), comprendente a sua volta una buca (36) nella quale detto dispositivo sensore (40; 50) è depositato.
- 6. Dispositivo secondo la rivendicazione 4 o 5 caratterizzato dal fatto che detto strato ad alta coercitività (32) contiene lo strato comprimibile

- (31) che è realizzato in forma di gel o schiuma o liquido.
- 7. Dispositivo secondo la rivendicazione 5 caratterizzato dal fatto che detto strato ad alta coercitività magnetica (32; 42) comprendente particelle magnetiche (33) contenute in una matrice resiliente è atto a svolgere anche la funzione di strato comprimibile (42).
- 8. Dispositivo secondo le rivendicazioni da 1 a 7, <u>caratterizzato dal fatto che</u> lo strato comprimibile (21; 32; 42) è realizzato per mezzo di un materiale composito poroso.
- 9. Dispositivo secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, <u>caratterizzato dal fatto che</u> detta pluralità di strati (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) disposti in pila configura un dispositivo magnetico di tipo spin valve (10).
- 10. Dispositivo secondo le rivendicazioni da 1 a 9, caratterizzato dal fatto che è associato a un sistema di monitoraggio e/o ripristino di pressione di uno pneumatico (52) disposto su una ruota (50), detto sistema comprendendo una centralina di controllo (56) e uno o più attuatori (52) per insufflare aria nello pneumatico (52).
- 11. Procedimento di fabbricazione di un dispositivo sensore di pressione secondo le

rivendicazioni da 1 a 9, caratterizzato dal fatto che prevede di depositare detto strato comprimibile (21; 31) tramite un processo di spinning e/o tramite un processo di casting e/o per evaporazione.

- 12. Procedimento di fabbricazione secondo la rivendicazione 11 <u>caratterizzato dal fatto che</u> prevede di depositare detto strato magnetico ad alta coercitività (22; 32; 42) tramite tecniche di evaporazione e/o di elettrodeposizione mediante cella elettrochimica.
- 13. Procedimento di rilevazione di pressione impiegante il dispositivo secondo le rivendicazioni da 1 a 9, caratterizzato dal fatto di prevedere le seguenti operazioni:
- realizzare detto strato comprimibile (21; 31) di uno spessore (D) non compresso maggiore di uno spessore di soglia (D_{th}) al di sotto del quale lo strato ad alta coercitività (22; 32; 42) influenza la magnetizzazione (MT) dello strato magnetico libero (11);
- forzare una corrente elettrica (I) in detto dispositivo sensore (20; 30, 40, 50);
- misurare il valore della resistenza elettrica di detto dispositivo sensore (20; 30, 40, 50) (14) in funzione dei valori assunti dalla pressione (P).
 - 14. Procedimento secondo la rivendicazione 13,

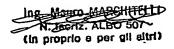
caratterizzato dal fatto di associare una soglia di pressione (P_{th}) a detto spessore di soglia (D_{th}).

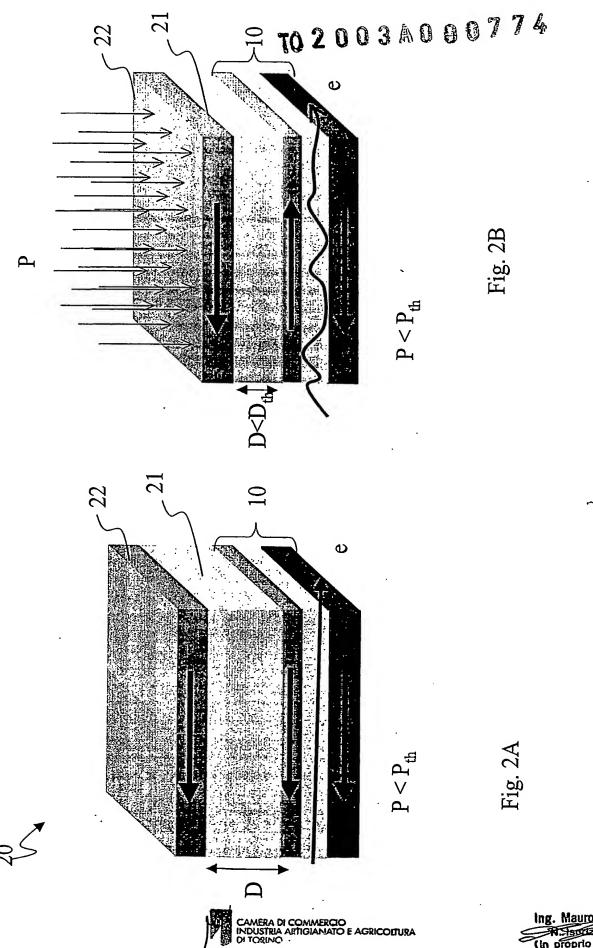
Il tutto sostanzialmente come descritto ed illustrato e per gli scopi specificati.

Ing. Maura MARCHITETTO N. 1804z. ALBO 507 (In proprio e per gli altri)

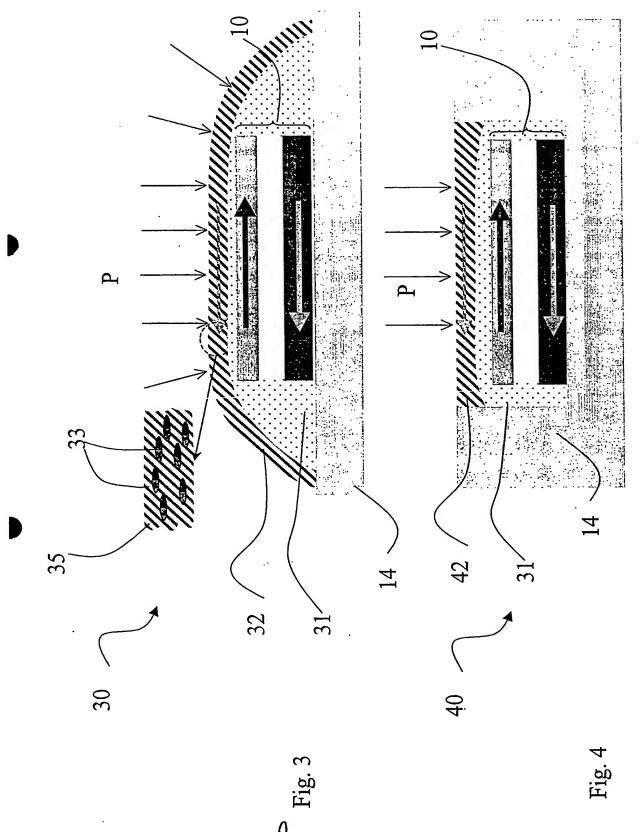








Ing. Mauro MARCHITELLI M. Isone Actio-ser (In proprio e per gli altri)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO Ing. Maum MARCHITELLS
N. 15-42: ALBO 507
(In proprio e per gli altri)

TO 2 0 0 3 A 0 0 0 7 7.4

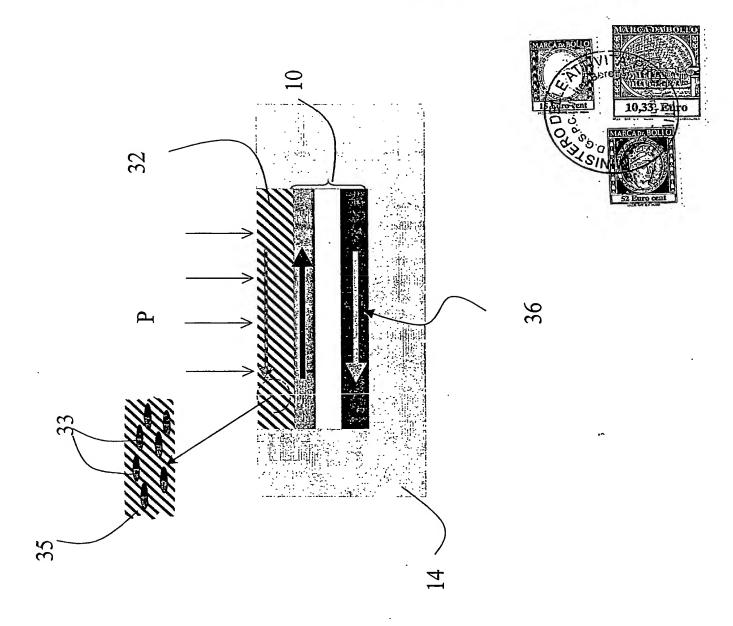


Fig. 5



